磁気ヘッド膜の反強磁性/強磁性界面における Mn 磁気構造の評価

平野辰巳(5097)¹、上田和浩(5099)¹、角田匡清(15753)²、仲真美子(15767)²) 吉滝慎一郎(16466)²、磯上慎二(18172)²、中村哲也(3439)³、大沢仁志(2025)³)

¹⁾(株)日立製作所、²⁾東北大、³⁾JASRI

1. 緒言

記録密度の高い磁気ヘッドを開発および量産 する上で解決すべき課題の一つに、反強磁性/ 強磁性(AFM/FM)間の安定した交換磁気結合の 実現がある。この解決には、交換結合の起源の 解明やAFMの材料系、配向、粒径などの制御因 子によるAFM/FM界面における磁気構造の評価 が極めて重要である。最近、X線磁気円二色性 (XMCD)を用いた元素選択磁気ヒステリシス法 (ESMH)により、AFM/FM界面のMn磁化におい て、外部磁場により回転および固着された成分 があることが報告された[1]。これは、MnのESMH ループにおける磁化方向(縦軸)のシフト量を界 面に固着された磁化成分(Mpin)と解釈している。 従来、理想界面で計算される交換結合エネルギ ー(J)[2]に比べて、多結晶試料で測定された交 換結合エネルギー(Jk)は、一桁小さいという問題 があった。上記報告によれば、AFM/FM界面に 固着されたMpinの被覆率(ρ)は4%となり、 $J_k \sim$ ρ Jとして説明している。即ち、MpinがJ_kに寄与 すると解釈している。そこで、本報告では、AFM の材料として、MnPt系(L10規則相)で配向/粒径 の差異によりJkが異なる試料、および界面での組 成が同じMnIr系(同じJ)で、Jkが2倍異なる不規則 相(fcc)と規則相(L12)の試料を用いて、上記解釈 の検証を目的とした。

2. 実験方法

MnPt 系試料は、ガラス基板/下地膜/ MnPt(15)/CoFe(2)/Cu(1)/Ru(2)とし、下地膜に より、配向([111]、[110])と粒径を制御して異なる J_k (0.1~0.3erg/cm²)の試料を作製した。括弧内 の数値は膜厚でnm単位である。MnIr系試料は、 SiN メンブレン基板(100)/CrNiFe(5)/Ru(20)/ MnIr(10)/CoFe(2)/Ru(1)/CrNiFe(1)とした。MnIr 成膜時の熱処理条件により、不規則相(J_k =0.6erg/cm²)と規則相(J_k =1.2 erg/cm²)の試料を

作製した。

MnPt 系試料は、全電子収量法(TEY)で測定した。MnIr 系試料は、高 S/N で測定できる透過法を用いた。

測定にはSPring-8/BL25SUの軟X線MCD装置を用いた。XMCDは、2台の挿入光源からの右回り/左回りの円偏光X線を切り替える偏光反転法により測定した。試料表面と外部磁場および入射X線のなす角度は、20度および30度とした。また、AFM/FMの着磁方向と入射X線の平行/反平行配置のESMHループは、(1)分割した試料の着磁方向を反平行とした試料固定(TEY法)、(2)試料の180回転(透過法)により測定した。高S/Nでの測定のために、1)分光器直下のスリットサイズの最適化、2)挿入光源のギャップの最適化、3)試料近傍の低ノイズ化、4)信号処理系の低ノイズ化などを実施した。

3. 実験結果

図1にMnPt系試料のCoとMnのESMHルー プを示す。赤線は、AFM/FM の着磁方向と入射 X線が平行配置、青線は、反平行配置を示す。 AFM のスピン(Mn)は本来、そのスピンベクトルの 方向が打ち消しあって全磁化量は0となるが、界 面で接触した強磁性層により、非打消し成分が 誘起されて全磁化量は0とならない。CoとMnの ESMH ループは同形であり、CoのスピンとMnの 非打し消スピンはフェロ結合である。横軸方向の バイアスシフト量は、Jkにより異なる。AFM/FM界 面に外部磁場で回転しない、固着した磁化成分 (Mpin)が存在すると、その MH ループは上下方 向(縦軸)にシフトし、平行/反平行配置のMHル ープは、飽和磁場で一致しない。図1より、Mnの 平行/反平行配置の MH ループは、飽和磁場 でほぼ一致しており、配向/粒径が異なる MnPt 系では、Mpin は存在していないと思われる。

図2にMnIr系試料のCoとMnのESMHルー

プを示す。不規則相、規則相ともMnの平行/反 平行配置のMHループは、飽和磁場で一致して おり、Mpinは存在していない。

以上の結果から、交換結合の起源としては、ス ピンフラストレーションモデル[3]やドメインモデル [4]が妥当と考えられ、AFM/FM界面からの深さ 方向の Mn のスピン構造が重要となる。

[1] Ohldag et. al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 17203.

- [2] Meiklejohn & Bean, Phys. Rev. 102 (1956) 1413.
- [3] Mitsumata et. al., Phys. Rev. B 68 (2003) 14437.
- [4] Mauri et. al., J. Appl. Phys. 62 (1987) 3047.



